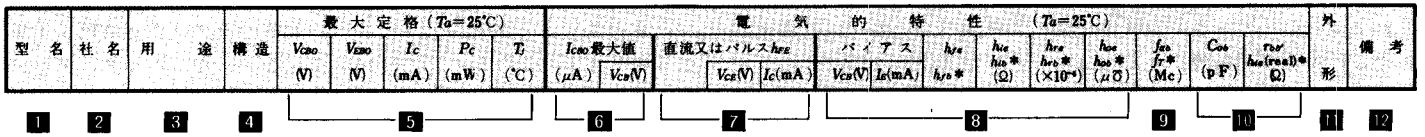
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD386	三洋	PA	Si.TMe	200	6	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500									268	
★	〃 387	〃	〃	〃	200	6	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500									267	
★	〃 388	日電	〃	〃	150	7	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	80	5	1 A	10	−200				9 *	190		102	2SB541 とコンプリ
	〃 389	松下	〃	Si.DJ	60	8	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200				$f_{\alpha e}$ 25kHz			268	
★	〃 390	〃	〃	〃	60	8	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200				$f_{\alpha e}$ 25kHz			267	
	〃 391																							
★	〃 392	三菱	PA	Si.EP	20	5	300	300	125	1	20	150	2	150	6	−10				150 *			138B	2SB542 とコンプリ
★	〃 393	〃	PA. SW	Si.EbMe	500	5	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	400	7	5	5 A			t_{off}=4μS (I_C=5A, I_{B1} = −I_{B2}=1.3A)						102	
★	〃 394	〃	〃	〃	700	5	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	450	7	5	5 A									102	
★	〃 395	〃	〃	〃	700	5	8 A	100W (Tc=25°C)	150	10	450	8	5	7 A									102	
	〃 396	日立	〃	Si.TMe	700	6	15A	125W (Tc=25°C)	150	5	400	30	2	7.5A			t_{on}<15μS, t_{off}<40μS t_{stg}<20μS						102	
	〃 397																							
	〃 398																							
	〃 399																							
★	〃 400	三洋	PA	Si.EP	25	5	1 A	900	150	1	20	60~560	2	50	10	−50				180 *	15		294	2SB544 とコンプリ
★	〃 401	日電	〃	Si.TMe	200	5	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400				5 *			268	2SB546 とコンプリ
★	〃 402	〃	〃	〃	200	5	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400				5 *			267	2SB547 とコンプリ
	〃 403																							
	〃 404	東芝	PA	Si.DJ	50	7	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	200	1	1 A									268	
	〃 405	日電	SW.PA	Si.E	70	7	2 A	1 W	175	1	50	4000	2	1 A									84B	ダーリントン
	〃 406	〃	〃	〃	100	7	2 A	1 W	175	1	70	4000	2	1 A									84B	ダーリントン
	〃 407	〃	〃	Si.EMe	100	7	5 A	25W (Tc=25°C)	175	10	80	4000	2	5 A									83	ダーリントン
	〃 408	〃	〃	〃	150	7	5 A	25W (Tc=25°C)	175	10	100	3000	2	5 A									83	ダーリントン
	〃 409	〃	〃	〃	100	7	5 A	30W (Tc=25°C)	175	10	80	4000	2	5 A									134	ダーリントン
	〃 410	〃	〃	〃	150	7	5 A	30W (Tc=25°C)	175	10	100	3000	2	5 A									134	ダーリントン
	〃 411	〃	〃	〃	100	8	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	2	10A									102	ダーリントン
	〃 412	〃	〃	〃	150	10	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	4000	2	15A									102	ダーリントン
	〃 413	富士通	PA. SW	Si.TMe	200	5	500	800	175	5	150	65	5	200	5	−50	t_r<2μS, t_f<2μS t_{stg}<5μS			25 *	12.5		84B	
	〃 414	日電	PA	Si.E	120	5	800	10W (Tc=25°C)	150	1	80	90	5	200	5	−100				45 *	15		225	
	〃 415	〃	〃	〃	120	5	800	10W (Tc=25°C)	150	1	80	90	5	200	5	−100				45 *	15		225	